公告本

P2年12月30日 修正

以上各欄(由本局填充	Holl'%6 B	43
_	中文	應用於半導體產品生產之植入式可靠度分析系統	
于明名稱	英文	Building-In-Reliability Diagnosis System for Semiconductor Manufacturing	
	姓 名 (中文)	1. 簡維廷 2. 余菁蓉 3. 陳勝福	
÷	姓 名 (英文)	1. Wei-Ting Kary C 2. Jennifer Ching-Jung Yu 3. Benjamin Chen	
發明人 (共3人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 ROC 2. 中華民國 ROC 3. 中華民國 ROC	
	住居所 (中 文)		
	住居所 (英 文)	1. 2. 3.	
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 中芯國際集成電路製造(上海)有限公司	
	名稱或 姓 名 (英文)	1. Semiconductor Manufacturing International(Shang Hai) Corp.	
= ,	图 箱(中英文)	1. 中國 CN	
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)		
	住居所 (營業所) (英 文		
	代表人 (中文)	1. 王陽元	
	代表人 (英文)	1. Yang-Yuan Wang	

索號 91120000 年 月 日 修正

四、中文發明摘要 (發明名稱:應用於半導體產品生產之植入式可靠度分析系統)

六、英文發明摘要 (發明名稱:Building-In-Reliability Diagnosis System for Semiconductor Manufacturing)

The contribution of this patent application is to apply the building-in-reliability diagnosis system (BIRDS) in semiconductor manufacturing and reliability enhancement, especially on the wafer-level reliability (WLR). By using the prior knowledge on former technologies and records, a database is built to comprise all data from each machine, each process, each lot, and each wafer





第 2 頁

案號 91120000 年 月 日 修正

四、中文發明摘要 (發明名稱:應用於半導體產品生產之植入式可靠度分析系統)

六、英文發明摘要 (發明名稱:Building-In-Reliability Diagnosis System for Semiconductor Manufacturing)

and to properly categorize all data. Hence, when any variation appears, the possible defect and solution would be available by referring the system. Besides, by unifying all data (including yield and reliability), the causes of variations on reliability are traceable and, thus, controllable. The BIRDS also provides information for new technology development and can predict



第 3 頁

衆號 91120000	年 丿	B B	修正
	·		

四、中文發明摘要 (發明名稱:應用於半導體產品生產之植入式可靠度分析系統)

六、英文發明摘要 (發明名稱:Building-In-Reliability Diagnosis System for Semiconductor Manufacturing)

lifetime of various reliability tests of advanced processes/ technologies, give related reliability issues and the current solutions.



第 4 頁

2003.10.30.004

案號 9	1120000	<u>年月</u>	8		
·、本案已向					
国家(地區)申請專利	申請日期	案號		主張專利法第二十四條第一項優先權	
					1
	·	無			
		•			
二、□主張專利法第二	十五條之一第一項	優先權:			
申請案號:		.			
日期:		無			
三、主張本案係符合專	利法第二十條第一	·項 第一計但	拿出厂2	第二款但書規定之期間	
	11/4 31 1 06 31	WENT WE	-~		
日期:					
四、□有關微生物已寄	存於國外:			*	
寄存國家: 寄存機構:		無			
寄存日期:					
寄存號碼:					
□有關微生物已寄	存於國內(本局所	指定之寄存機材	事):		
寄存機構: 寄存日期:		無			
寄存號碼:		,,,,,			
□熟習該項技術者	易於獲得,不須寄	存。			
					_
		. •			
				•	

第 5 頁

衆號 91120000

五、發明說明(1)

【發明領域】

本發明係有關於應用植入式可靠度分析系統
(building-in-reliability diagnosis system, BIRDS)
於半導體產品生產,特別是應用植入式可靠度分析系統於晶圓層級(wafer-level)之可靠度分析。

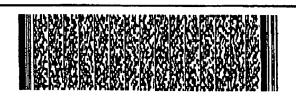
【發明背景】

習知技術中,大多是在晶圓完工、晶粒(chip)切割與個別晶粒封裝完成後,才進行的半導體元件的可靠度分析與品管測試。一般稱此為封裝層級可靠度(package-level reliability, PLR)之測試分析。而由於封裝層級可靠度分析已廣泛地被使用,不只相關的技術與產品已成熟,測試所得資料與分析所得結果也已有足夠的公信力。

但是封裝層級可靠度分析有一個無法避免的缺失:相關的測試步驟相當的花時間,動輒數月之久。因此,隨著半導體產品的商品生命期快速縮短,封裝層級可靠度分析使用便面對兩難的困境:若耗時數月進行封裝層級可靠度分析來確定某產品的可靠度,此產品往往已錯失市場時機;若不作完整的封裝層級可靠度分析便讓某產品上市以爭取時效,又不能確定此產品之可靠度。

同時,隨著半導體產品的日益複雜,封裝層級可靠度分析所需要進行的步驟、所需要使用的機台與所需要測試樣品的數目都大幅增加。由於習知技術中,雖然個別步驟、個別機台與個別樣品都有專人負責,將此步驟/機台/樣





第6頁

2003, 10, 30, 006

索號 91120000

年月日 修正

五、發明說明 (2)

品的品管與可靠度極佳化,但並沒有統合所有部門(步驟/機台/樣品)之品管與可靠度。因此,封裝層級可靠度分析之可靠度往往不能極佳化(因為不同部門之間可能會相互抵消),而且不同個體也不能分享彼此的經驗與資訊。

近年來,針對封裝層級可靠度分析耗時過久的缺失, 諸如德州儀器等公司已逐漸發展出測試速度快得多的晶圓 層級(wafer-level)可靠度分析。藉由在晶圓上各晶粒製 程中或形成好後便進行可靠度測試,待測試(如晶圓針測 ,CP)通過驗證後才進行切割封裝的作法,可以大幅度減 少可靠度測試所需要的時間。當然,晶圓層級可靠度分析 與封裝層級可靠度分析二者的步驟有所不同。

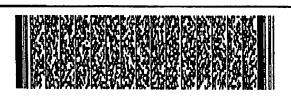
但是,習知之晶圓層級可靠度分析的實際應用,仍會遭遇下列二個缺失:第一、習知晶圓層級可靠度分析也無法有效整合各步聯/機台/樣品的品管與可靠度,因此往往不能將整體品管與可靠度最佳化;第二、某些晶圓層級可靠度分析缺乏實驗數據與理論根據,來證明其與封裝層級可靠度分析是等效。

綜上所述,與半導體製程之品管與可靠度有關的習知 技術,都有尚待解決之不可忽略的缺失。

【發明目的及概述】

本發明一主要目的是提供可以有效整合各步骤/機台/ 樣品的良率與可靠度,進而將整體品管與可靠度最佳化的 方法。





第 7 頁

衆號 91120000

并月日 修」

五、發明說明(3)

本發明另一主要目的是提供數據可以證明晶圓層級可靠度分析以及封裝層級可靠度分析二者是否等效與相對應關係的方法。

本發明的基本特徵是應用近年才被提出的植入式可靠度分析,來整合各個層級可靠度分析。特別是應用建立在各種可靠度分析測試資料的資料庫(database)與分析工具,來有效發揮各種層級之可靠度分析。由於植入式可靠度分析系統是已知技術,在此將不多介紹,相關的細節至少可參閱:W.K.T. Kary Chien & Charles H.J. Huang,

"Practical Building-In Reliability (BIR)
Approaches for Semiconductor Manufacturing", IEEE
Transactions on Reliability, vol. 51 no 3,
September 2002.

本發明之應用,至少還可具有下列幾個特徵:

- (1)利用BIRDS,可以掌握任何參數與最終結果的關係,不論這個參數是最終測量/最終產品的參數,或是中間測量/中間產品的參數。因此,藉由參考BIRDS,可以在產品設計階段便有效評估各個細節與對最終產品可靠度/品質的影響,而不用等到產品形成後才進行可靠度的測量與修正。
- (2)任何與可靠度有關的問題,都可以透過BIRDS回溯 既往資料,依照經驗並透過推理引擎而有效地找到根本原 因。
 - (3)由於BIRDS是一個整合性的系統,可以建立現有技





第 8 頁

紫號 91120000 年 月 日 修正

五、發明說明(4)

術下包含所有與可靠度有關項目的資料庫。對新技術開發 、製程最佳化、製程監控、可靠度監控與良率改善,都可 以提供重要的參考依據。

【發明詳細說明】

首先,第一A圖與第一B圖顯示習知技術的一大基本特徵:只有在各機器11與各步驟12分別進行可靠度(或品管)的測量並獲得相關資訊13,但不同機器11與不同步驟12並沒有分享彼此的資訊13,而且不同機台間也有交互作用,這些常被忽略,但這些資料並無有目的性的被記錄,只是零散地存在不同的系統。

相對地,第一C圖與第一D圖顯示本發明的一大基本特徵,第所有個別的資訊13即時地整合成一個資料庫14,並使用習知之植入式可靠度分析15,配合電腦化工具機器11與各步驟12的進行。如此作,本發明可靠度的與各步驟12與各機器11運作前,便考量可能影響可靠度的因素而進行調整;可以在各步驟12與各機器11運行中,便即時根據正可以整合各機器11與各步驟12個別調整,以追求最終正產與整條生產線之最佳化可靠度。

根據上述之基本概念,本發明一較佳實施例為一種應用植入式可靠度分析系統於半導體產品生產的方法。如第二圖所示,至少包含下列基本步驟:





第 9 頁

2003. 10. 30, 009

衆號 91120000

年月日 修正

五、發明說明 (5)

如第一背景方塊21 所示,準備多數個機器與多數個晶圖。在此任一機器是用來對至少一晶圓進行至少一可靠度分析程序,而任一晶圓至少被一機器所處理。

如第二背景方塊22所示,準備一植入式可靠度分析系統。此植入式可靠度分析系統至少包含資料庫(Database)、評估總成(Assessment assembly)、基線總成(Baseline assembly)、控制總成(Control assembly)與發展總成(Development assembly)、搜尋總成(Search assembly)、查詢總成(Query assembly)、與分析總成(Analysis assembly)。

如調整方塊23所示,參考植入式可靠度分析系統,調整這些機器與這些可靠度分析程序的參數。

如可靠度测量方塊24所示,使用這些機器對這些晶圓進行這些可靠度分析程序,並同時記錄任一可靠度分析程序、任一機器與任一晶圓之多數個資訊。在此,這些資訊除了至少包含任一可靠度分析程序之運作參數、任一機器之工作參數以及任一晶圓之測量結果,更包含了可靠度分析程序所發現或發生的問題,以及解決問題的方式。

如回饋方塊25所示,分析並整合這些資訊至植入式可靠度分析系統,藉以獲得半導體產品之產品可靠度與半導體產品製造過程之製程可靠度,並更新植入式可靠度分析系統。

在此,必須強調的是本實施例並沒有限定所使用可靠度分析程序的細節,本實施例可以應用在傳統之封裝層級





第 10 頁

索號 91120000

年 月 日 ___ 修』

五、發明說明 (6)

可靠度分析程序或是新進產品之晶圆層級可靠度分析程序。本實施例所使用之可靠度分析程序至少可以是下列之一(但不限於此):製程驗證(Process Qualification)相關程序、產品驗證(Product Qualification)相關程序、產品辦估(Process Evaluation)相關程序、產品評估(Product Evaluation)相關程序、製程監測(Process Monitor)相關程序、定期產品監測(Routine Product Monitor)相關程序、在線製程評估與監測(In-Line Process Evaluation & Monitor)相關程序。

製程驗證(Process Qualification)及監測(Monitor)相關程序至少可以是下列之一(但不限於此): 熱載子注入測試(Hot Carrier Injection Test)、介電質崩潰時間測試(Time Dependent Dielectric Breakdown Test)、崩潰電壓測試(Voltage Ramp Test)、偏壓溫度測試(Bias Temperature Test)、電子邊移測試(Electromigration test)、離子移動率測試(Ion Mobile Test)、應力邊移測試(Stress Migration Test)、電漿引發損壞測試(Plasma Induced Damage Test)。

晶圈層級可靠度控制(Wafer-Level-Reliability Control)及監測(Monitor)與在線製程評估與監測(In-Line Process Evaluation & Monitor)相關程序至少可以是下列之一(但不限於此):熱載子注入測試(Hot Carrier Injection Test)、崩潰電壓測試(Voltage Ramp Test)、恒溫電子遷移(Isothermal





第 11 頁

衆號 91120000

年 月 日 移

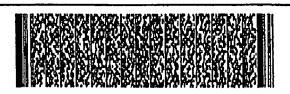
五、發明說明 (7)

Electromigration Test) .

產品驗證相關程序至少可以是下列之一(但不限於此) : 高溫壽命測試 (High Temperature Operating Life Test) 、低溫 春 命 測 試 (Low Temperature Operating Life Test)、早期失效率測試(Early Failure Rate Test)、加速老化測試(Highly Accelerated Stress Test)、預條件測試(Pre-conditioning Test)、壓力鍋 測試 (Pressure Cooker Test)、恒温恒温測試 (Temperature & Humidity With Bias Test) 、熱衝擊 測試(Thermal Shock Test)、溫度變化循環測試 (Temperature Cycling Test)、 高温 儲存測試(High Temperature Storage Test)、低温應力測試(Low Temperature Stress Test)、加速軟錯誤率測試 (Accelerated Soft Error Rate Test)、静電放電測試 (Electrostatic Discharge Test)、栓鎖測試(Latch Up Test)、系統軟錯誤率測試(System Soft Error Rate Test) •

另外,由於本實施例所引用的植入式可靠度分析,是一種可以適合即時(in-time)反應的方式。在可靠度測量方塊24中,本實施例往往是一面進行可靠度分析程序,一面將相對應資訊進行分析與整合。進一步地,由於傳統封裝層級可靠度分析程序往往不能一面進行生產一面測量, 只有新進之晶圓層級可靠度分析程序往往可以一面進行生產一面測量,因此本實施例特別適用於晶圓層級可靠度分





第 12 頁

衆號 91120000

年月日 修正

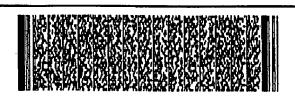
五、發明說明 (8)

析。

在此,由於植入式可靠度分析是近年新被提出的概念,已算是習知技術的概念而只是幾乎未曾被具體應用,在此,將不針對植入式可靠度分析的細節進行解釋,只是摘要描述本實施例所使用建立在植入式可靠度分析之可靠度分析系統的一些主要特徵如下:

- (1)不被動地測量最終產品,而是直接測量與控制最終產品製造過程之多數參數。例如各機器之工作參數,或是各步驟之流程參數,以預知產品可靠度。
- (2)垂直整合完整流程(flow)中前後進行之多數個次流程(sub-flow)(或說多數個步驟)的多數資料,藉以克服習知技術中不同次流程之個別品管/可靠度相關訊息無法系統化交流的缺點。
- (3)水平整合同一次流程中同時分別進行之多數單元 (如多數機器)的多數資料,藉以克服習知技術中不同單元 之個別品管/可靠度相關訊息無法系統化交流的缺點。
- (4)藉由持續記錄與分析比較來自於多數個來源之多數筆資料,來評估任一來源的可靠度以及任一來源的變化對整體的影響。
- (5)透過資料分析的方法建立可靠度與其它參數的關係。在此可能應用的資料分析至少有貝式定理 (Bayesian Approach) 、管制圖 (Statistical Control Chart)、因素分析 (Factor Analysis)、變異數分析
 - (Analysis of Variances)、多變量分析





第 13 頁

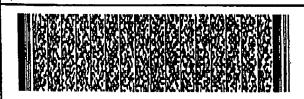
余號 91120000

年月日 修正

五、發明說明 (9)

(Multivariate Analysis)、判別分析(Discriminant Analysis)、主成份分析(Principal component analysis)、實驗設計/反應曲面(Designs of Experiments/Response Surface Method)、迴歸分析(Regression Analysis)、決策樹(Decision Tree)、迪克萊特程序(Dirichlet Process)、混合整數規劃(Mixed Integer Programming)、線形及非線性規劃(Linear/Non-linear Programming)、等候理論(Queuing Theory)、隨機過程(Stochastic Process)、資源規劃(Resources Planning),而可能的其它參數至少有製程監控參數、良率、特定之晶圓接受度測試(Wafer Acceptance Test)參數、線上機器參數、晶圓針測(Chip Probing)參數、最終檢測(Final Test)參數、可靠度測試參數。

- (6)透過資料分析所建立之可靠度與其它參數的關係,包含任一該參數之參數值與最終產品之可靠度的關係。因此,可以在製程進行中發現此參數值異常時,便能預測最終產品之可能缺失與可靠度,進而據以進行修改。
- (7)透過資料分析方式,比較不同製程技術下可靠度 與某些特定參數間關係的變化,提供從已有製程技術之可 靠度推算新製程技術之可靠度的途徑。例如根據已成熟之 0.30,025,0.20微米製程與0.18微米製程的電子遷移測 試與介電質崩潰測試等的測試資料,推算不同製程之參數 與成品的關係,進而推算正在發展中之0.15及0.13微米製





第 14 頁

2003. 10. 30. 014

案號 91120000 年 月 日 修正

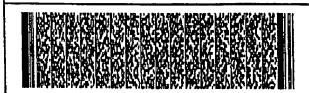
五、發明說明 (10)

程與0.18微米製程的參數與成品關係。

當然,為了與其它技術及其它電腦軟體相整合,本實施例可以讓植入式可靠度分析系統之資料格式與其它常見資料分析軟體相容,例如Excel、JMP、MATLAB與SAS。

除此之外,為了讓任何使用者都可以獲得任何先前建立與這些機器、這些晶圓與這些可靠度分析程序有關的思。,本實施例還提供了搜尋總成與查詢總成,提供使用者的資料庫主動搜索並獲得所需訊息的管道。當然,搜專的人工智慧,最好是具有學習的功能,可以根據歷次查詢的關鍵字使用過程與最終查詢結果的關係,修改搜尋使用的規則,並建立不同使用者的個人化搜尋規則。

進一步地,由於植入式可靠度分析系統可以記錄任何





第 15 頁

2003. 10. 30. 015

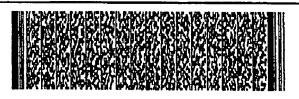
紫號 91120000 年 月 日 修正

五、發明說明(11)

除此之外,本實施例可使用該植入式可靠度分析系統提供防呆功能。藉由參考植入式可靠度分析系統已储存之資料,如果某機器或某步驟之操作人員在調機器與可靠度分析程序的參數時,所設定的參數值有格式錯誤或與資料庫之可接受標準值有明顯偏差,便主動發出警告。

本發明之另一較佳實施例為一種應用植入式可靠度分析於半導體產品生產的系統。如第三A圖所示,至少具有:植入式可靠度分析總成31、失效處理總成32、失效報告總成33、排程總成34、產品驗證/監測/評估(Product Qualification)報告總成35、製程驗證/監測/評估(Process Qualification)報告總成36、晶圓層級可靠度控制/在線製程評估/監測(Wafer Level reliability Control)總成37、報告總成38和分析總成39。





第 16 頁

2003. 10. 30. 016

索號 91120000

年月日 修正

五、發明說明 (12)

植入式可靠度分析總成31同時與多數機器、多數產品與多數製程步驟交換多數資料,並使用習知之植入式可靠度分析處理這些資料而產生多數運作相關訊息。

失效處理總成32接收植入式可靠度分析總成31所傳輸過來之與這些機器、這些產品驗證與這些製程驗證相關之多數失效訊息,並分析這些訊息。失效報告總成33根據失效處理總成32所產生的多數失效相關訊息,產生與這些機器、這些產品驗證與這些製程驗證相關之多數失效報告。

排程總成34根據這些運作相關訊息安排這些機器、這些產品與這些製程步驟的工作流程,並提供與排定工作流程相關之多數工作相關訊息,以使機台使用率及人力配置可以儘可能地最佳化。如當資料異常時排程總成能追蹤到相關測試機台的歷史資料,以瞭解機台的準確度

(Accuracy)與精確度(Precision),進而從這些資料追蹤到相對出問題之機台;顯示每個測試者做了哪些測試;此外,排程總成會主動通知測試者何時測試;並會顯示每一機台的目前狀態及利用率,如有多個申請者申請同一時段使用同一機台,則會主動告知相關人員以進行協商,以使各種資源能達到最佳利用。

產品驗證/評估/監測報告總成35透過植入式可靠度分析總成31以及這些運作相關訊息,產生與這些產品相關之多數產品品質訊息。製程驗證/評估/監測報告總成36透過植入式可靠度分析總成31以及這些運作相關訊息,產生與這些製程驗證相關之多數製程性能訊息。晶圓層級可靠度





第 17 頁

2003.10.30.017

衆號 91120000

年 月 日 修正

五、發明說明 (13)

控制/在線製程評估/監測總成37透過植入式可靠度分析總成31以及這些運作相關訊息,產生與這些產品、這些機器與這些製程步驟相關之多數可靠度訊息。

報告總成38係根據自動輸入的產品驗證/監測/評估報告總成35、製程驗證/監測/評估報告總成36以及晶團層級可靠度控制/在線製程評估/監測總成37相關資料,產生與這些機器、這些產品驗證與這些製程驗證相關之綜合預測之餘,自動俱察固定儲存區是否有新的測試資料,如有新的測試資料,則將資料自動鍵入資料庫,以減去人工輸入所造成的錯誤、降低測試者之負擔;此外,報告總成利用自動生成的關鍵詞,可查詢並快速找到所需的綜合報告及相關文檔。

分析總成39至少根據產品/監測/評估報告總成35、製程/監測/評估報告總成36、晶圓層級可靠度控制/在線製程評估/監測總成37以及失效報告總成33產生與這些機器、這些產品驗證與這些製程驗證相關之綜合性資料分析。並可視需要進一步根據排程總成34及/或失效報告總成33來產生與這些機器、這些產品驗證與這些製程驗證相關之綜合性資料分析。

在此,由於產品/監測/評估報告總成35、製程驗證/ 監測/評估報告總成36以及晶圓層級可靠度控制/在線製程 評估/監測總成37的主要功能是產生這些產品品質訊息、 這些製程性能訊息、這些可靠度訊息,因此報告總成38可





第 18 頁

宏號 91120000

年月日 修正

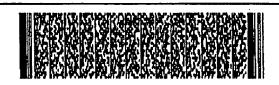
五、發明說明 (14)

以僅根據這些訊息來產生綜合報告,分析總成39也可以僅根據這些來進行綜合性資料分析。

相同地,由於排程總成24已接收植入式可靠度分析總成21所產生之所有運作相關訊息,如第三B圖所示,本實施例可以讓產品驗證/監測/評估報告總成35透過排程總成34與植入式可靠度分析總成31連接;可以讓製程/監測/評估報告總成36係透過排程總成34與植入式可靠度分析總成31連接;可以讓晶圓層級可靠度控制/在線製程評估/監測總成37透過排程總成34與植入式可靠度分析總成31連接,也可以讓分析總成39透過失效報告總成33與失效處理總成32連接。當然,第三B圖所示僅為一種可能架構,本實施例並不限定植入式可靠度分析總成31必須同時透過排程總成34與產品驗證/監測/評估報告總成35透過、製程驗證/監測/評估報告總成36以及晶圓層級可靠度控制/在線製程評估/監測總成37進行連接,而是可以個別地透過排序總成34進行接收。

此外,為了提供回饋的功能,如第三C圖所示,植入式可靠度分析總成31可以接收綜合報告,並整合綜合報告至這些運作相關訊息;植入式可靠度分析總成31也可以接收綜合性資料分析,並整合綜合性資料分析至這些運作相關訊息;並且植入式可靠度分析總成31也可以接收失效報告,並整合失效報告分析至這些運作相關訊息。當然,第三C圖所示僅為一種可能架構,本實施例並不限定植入式可靠度分析總成31必須同時接收綜合報告、運作相關訊息





第 19 頁

索號 91120000 年 月 日 修正

五、發明說明 (15)

以及失效報告,而是可以個別地接收。

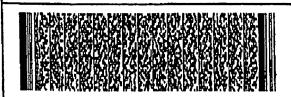
再者,晶圆唇級可靠度控制/在線製程評估/監測總成 37可以進行晶圓層級可靠度分析,本實施例並不限制這些 細節。但為了發揮植入式可靠度分析的性能,本實施例較 適合應用在可以即時監測之晶圓層級可靠度分析。舉例來 說,晶圓層級可靠度控制/在線製程評估/監測總成37可以 進行的各種可靠度分析程序可以是選自下列各種測試:熱 載子注入測試、電子遷移測試、崩潰電壓測試。

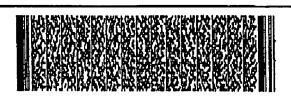
接下來,為了簡明地強調應用本發明對半導體產品生產程序的影響,第四A圖至第四D圖分別顯示習知半導體製造程序以及應用本發明之半導體製造程序的基本流程。

如第四A 圖與第四B 圖所示,習知半導體製造程序通常可以分為四大步驟方塊(研發設計步驟方塊41、製造步驟方塊42、測試方塊43以及可靠度分析方塊44)與二大相關訊息方塊(製造步驟相關資料方塊45)。

研發設計步驟方塊41係指正式進行生產之前的一切動作,例如符製造產品的產品規格開發、符製造產品之測試以及待進行之製造步驟的調整測試等等。

製造步驟方塊42係指正式進行符製造產品之生產的一切動作,例如晶圓清潔(clean)、氧化(oxidation)、熱處理(thermal treatment)、微影(photolithography)、蝕刻(etching)、掺雜(doping)、擴散(diffusion)、金屬等線形成(metalization)等等。





第 20 頁

衆號 91120000

年 月 日 修正

五、登明说明(16)

測試方塊43係指在產品製造好後對產品之品質等的測試動作,例如晶圓接受度測試(wafer acceptance test)以及晶粒探針測試(chip probing test)。

可靠度分析方塊44係指對大批產品以及相關製造步驟之可靠度分析,至少製程可靠度及產品可靠度這二部份的可靠度。

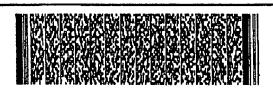
製造步驟相關資料方塊45係指製造步驟方塊42中所有動作的進行、執行這些動作之機器、執行這些動作之操作人員等等,在進行製造步驟方塊42時所產生的一切資料。

產出相關資料方塊46係指測試方塊43中所有動作的進行、執行這些動作之機器、執行這些動作之操作人員等等,在進行測試方塊43所產生的一切資料。

如第四C圖與第四D圖所示,應用本發明之半導體製造程序除了擁有習知之三大步驟方塊(研發設計步驟方塊41、製造步驟方塊42以及測試方塊43)與二大相關訊息方塊(製造步驟相關資料方塊45以及產出相關資料方塊46)外,退額外擁有植入式可靠度分析方塊47以及線上可靠度監測次方塊48以及可靠度控制次方塊49。在此,植入式可靠度分析方塊47取代了習知技術之可靠度分析方塊44,而線上可靠度監測次方塊48至少可以是晶圓層級可靠度分析。

植入式可靠度分析方塊47係用以執行植入式可靠度分析的方塊,與習知技術之可靠度分析方塊44相比較,至少具有下列的特徵:





第 21 頁

2003, 10, 30, 021

索號 91120000 年 月 日 修正

五、發明說明 (17)

- (1)植入式可靠度分析方塊47會接收製造步驟相關資料方塊45以及產出相關資料方塊46,並根據這些資料來進行植入式可靠度分析。
- (2)植入式可靠度分析方塊47會分別與製造步驟方塊 42以及測試方塊43二者進行系統化地互動,例如資料交換、即時修正、以及即時狀況報告等等。
- (3)植入式可靠度分析方塊47會系統化地將運作結果 傳輸至研發設計步驟方塊41。藉此,使得研發設計步驟方 塊41的運作即可引入可靠度的考量。
- (4) 植入式可靠度分析方塊47至少可以進行下列的動作:製程可靠度評估、晶圆層級可靠度分析、產品可靠度評估、數據分析、排程、報表產生、失效分析以及失效分析報告。

在此,線上可靠度監測次方塊48係作為植入式可靠度分析方塊47與製造步驟方塊42的界面,而可靠度控制次方塊49係作為植入式可靠度分析方塊47與製造步驟方塊42的界面。

顯然地,習知技術中不同步驟方塊(41/42/43/44)之間的關係為單行道,先進行方塊無法預知隨後進行方塊的內容,隨後進行方塊的內容也不能回饋至先進行方塊。並且不同訊息相關方塊(45/46)不只是相互獨立的,而且也無法回饋至各個訊息相關方塊(41/42/43/44)。

相對地,本發明可以讓不同步驟方塊(41/42/43/44)之間的關係為雙向來回,先進行方塊可以預知隨後進行方





第 22 頁

案號 91120000

五、發明說明 (18)

塊的內容,隨後進行方塊的內容也可以回饋至先進行方塊。並且不同訊息相關方塊(45/46)不只可以透過植入式可靠度分析方塊47相互整合的,也可以透過植入式可靠度分析方塊47回饋至各個訊息相關方塊(41/42/43/44)。

最後,必須強調地是上述實施例之各種可能變化、各種可能功能與各種構成都是相互獨立的,除非上述說明中有特別明文限制,應用各實施例時都可以視實際需要選擇所需要的變化、功能與構成。

以上所述僅為本發明之較佳實施例而已,並非用以限定本發明之申請專利範圍;凡其它未脫離本發明所揭示之精神下所完成之等效改變或修飾,均應包含在下述之申請專利範圍中。



第 23 頁

索號 91120000 年 月 日 修正

圖式簡單說明

【圖式簡單說明】

第一A 圖至第一B 圖為習知技術之主要特徵的模截面示意圖;

第一C圖至第一D圖為本發明之主要特徵的橫截面示意圖; 第二圖為本發明一較佳實施例的基本流程圖;

第三A圖、第三B圖及第三C圖為本發明另一較佳實施例的 基本構成圖;以及

第四A圖、第四B圖、第四C圖及第四D圖分別顯示習知半導體製造程序以及應用本發明之半導體製造程序的基本流程。

〔主要部分之代表符號〕

	•										
1	l 1	機	器								
]		步	騋							•	
]	1 3	資	訊								
•	1 4	資	料	庫							
	15	植	入	式	可	靠	度	分	析		
•	2 1	第	_	背	景	方	塊				
•	22	第	=	背	景	方	塊				
	23	調	整	方	塊						
	24	可	靠	度	測	量	方	塊			
	25	回	饋	方	塊						
	31	植	入	式	可	靠	度	分	析	總	成
	32	失	效	處	理	總	成				
	33	失	效	報	告	總	成				



第 24 頁

	案號 91120000	争	月 日 修正	
圖式簡單說明	·			
3 4	排程總成			
35	產品 驗 證/ 監	測/評	估報告總成	•
36	製 程 驗 證/ 監	測/ 評	估報告總成	
37	晶圆層級可靠	度控	制/在線製程評估/	监测總成
38	報告總成			
39	分析總成			
41	研發設計步驟	5 方塊		•
42	製造步驟方填	L		
43	测試方塊			
44	可靠度分析方	塊		•
45	製造步驟相關	資料	方 塊	
46	產出相關資料	 方塊	•	
47	植入式可靠房	分析	方 塊	
48	線上可靠度監	1 測 次	方 塊	
49	可靠度控制》	く方塊		
1				



第 25 頁

案號 91120000 年 月 日 修正

六、申請專利範圍

一種應用植入式可靠度分析系統於半導體產品生產的方法,包含:

準備多數個機器與多數個晶圓,在此任一該機器是 用來對至少一該晶圓進行至少一可靠度分析程序,而 任一該晶圓至少依序被一該機器所處理;

準備一植入式可靠度分析系統,該植入式可靠度分析系統至少包含一資料庫、一評估總成、一基線總成、一控制總成與一發展總成、一搜尋總成、一分析總成與一查詢總成;

參考該植入式可靠度分析系統,調整該些機器與該 些可靠度分析程序的參數;

使用該些機器對該些晶圓進行該些可靠度分析程序,並同時記錄任一該可靠度分析程序、任一該機器與任一該晶圓之多數個資訊,該些資訊至少包含任一該可靠度分析程序之運作參數、任一該機器之工作參數、任一該晶圓之測量結果、出現的問題以及解決問題的方式;以及

分析並整合該些資訊至該植入式可靠度分析系統, 藉以獲得該半導體產品之產品可靠度與該半導體產品 製造過程之製程可靠度,並更新該植入式可靠度分析 系統。

2.如申請專利範圍第1項之應用植入式可靠度分析系統 於半導體產品生產的方法,該些可靠度分析程序係屬 於一晶圓層級可靠度分析。





第 26 頁

索號 91120000 年 月 日

六、申請專利範圍

- 4. 如申請專利範圍第 1 項之應用植入式可靠度分析系統 於半導體產品生產的方法,係一面進行任一該可靠度 分析程序,一面將相對應之至少一資訊進行分析與整 合。
- 5.如申請專利範圍第1項之應用植入式可靠度分析系統於半導體產品生產的方法,該植入式可靠度分析系統係為應用習知之植入式可靠度分析的系統,其一大特徵是不被動地測量最終產品而是直接測量與控制最終產品製造過程之多數參數。
- 6. 如申請專利範圍第1項之應用植入式可靠度分析系統 於半導體產品生產的方法,該植入式可靠度分析系統 係為應用習知之植入式可靠度分析的系統,其一大特 徵是垂直整合一完整流程中前後進行之多數個次流程





修正

第 27 頁

2003, 10, 30, 027

索號 91120000 年 月 日 修正

六、申請專利範圍

的多數資料,藉以克服習知技術中不同次流程之個別品管/可靠度相關訊息無法系統化整合的缺點。

- 7. 如申請專利範圍第1項之應用植入式可靠度分析系統 於半導體產品生產的方法,該植入式可靠度分析系統 係為應用習知之植入式可靠度分析的系統,其一大特 徵是水平整合同一次流程中同時分別進行之多數單元 的多數資料,藉以克服習知技術中不同單元之個別品 管/可靠度相關訊息無法系統化交流的缺點。
- 8. 如申請專利範圍第1項之應用植入式可靠度分析系統 於半導體產品生產的方法,該植入式可靠度分析系統 的一大特徵是藉由持續記錄與分析比較來自於多數個 來源之多數筆資料,藉以評估任一該來源的可靠度以 及任一該來源的變化對整體的影響。
- 9.如申請專利範圍第1項之應用植入式可靠度分析系統於半導體產品生產的方法,該植入式可靠度分析系統係透過資料分析的方法建立可靠度與其它參數的關係,在此可能應用的統計方法至少有貝式定理、管制圖、因素分析、變異數分析、多變量分析、判別分析、主成份分析(Principal component analysis)、實驗設計/反應曲面、迴歸分析、決策樹、迪克萊特程序、混合整數規劃、線形及非線性規劃、等候理論、機過程、資源規劃等,而可能的其它參數至少有製程監控參數、良率、特定之晶圓接受度測試參數、可靠度測





第 28 頁

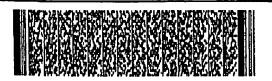
索號 91120000

年 月 日 修正

六、申請專利範圍

試多数。

- 10. 如申請專利範圍第9項之應用植入式可靠度分析系統 於半導體產品生產的方法,該植入式可靠度分析系統 透過統計所建立之可靠度與其它參數的關係,包含任 一該參數之參數值與最終產品之可靠度的關係。
- 11. 如申請專利範圍第 9 項之應用植入式可靠度分析系統 於半導體產品生產的方法,該植入式可靠度分析系統 尚可以透過統計方式,比較不同製程技術下可靠度與 某些特定參數間關係的變化,提供從已有製程技術之 可靠度推算新製程技術之可靠度的途徑。
- 12. 如申請專利範圍第1項之應用植入式可靠度分析系統 於半導體產品生產的方法,該植入式可靠度分析系統 之資料格式係與其它常見資料分析軟體相容,例如 Excel、JMP、MATLAB與SAS。
- 13. 如申請專利範圍第1項之應用植入式可靠度分析系統 於半導體產品生產的方法,該資料庫、該搜尋總成與 該查詢總成係用來讓任一使用者可以獲得任何先前建 立與該些機器、該些晶圓與該些可靠度分析程序有關 的訊息。
- 14. 如申請專利範圍第1項之應用植入式可靠度分析系統 於半導體產品生產的方法,尚可使用該植入式可靠度 分析系統所產生之圖示與報表,提供產品設計人員與 研發人員在產品實際在生產線進行生產前就可以考量 可靠度因素的參考訊息。





第 29 頁

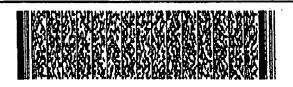
案號 91120000

年月日 修正

六、申請專利範圍

- 15. 如申請專利範圍第1項之應用植入式可靠度分析系統 於半導體產品生產的方法,尚可使用該植入式可靠度 分析系統所產生之圖示與報表,隨時提供測試結果報 告與失效分析報告,提供即時之可靠度資訊。
- 17. 如申請專利範圍第1項之應用植入式可靠度分析系統於半導體產品生產的方法,尚可使用該植入式可靠度分析系統提供防呆功能,在操作人員調整該些機器與該些可靠度分析程序的參數時,如果設定的參數值有格式錯誤或與該資料庫記錄之可接受正常範圍有明顯偏差,便主動發出警告。
- 18. 一種應用植入式可靠度分析於半導體產品生產的系統,包含:
 - 一植入式可靠度分析總成,該內應用植入式可靠度





第 30 頁

2003, 10, 30, 030

衆號 91120000

年月日 修正

六、申請專利範圍

分析總成同時與多數機器、多數產品與多數製程步驟 交換多數資料,並使用習知之植入式可靠度分析處理 該些資料而產生多數運作相關訊息;

一失效處理總成,該失效處理總成接收該植入式可靠度分析總成所傳輸過來之與該些機器、該些產品與該些製程步驟相關之多數失效訊息,並分析該些訊息:

一失效報告總成,該失效報告總成根據該失效處理 總成所產生的多數失效相關訊息,產生與該些機器、 該些產品與該些製程步驟相關之多數失效報告,失效 報告可透過模糊查詢快速取得;

一排程總成,該排序總成根據該些運作相關訊息安排該些機器、該些產品與該些製程步驟的工作流程,並提供與排定工作流程相關之多數工作相關制息;如當資料異常時排程總成能追蹤到相關測試機台的歷史資料,以瞭解機台的準確度(Accuracy)與精確度(Precision),進而從這些資料追蹤到相對出問題之機台;顯示每個測試者做了哪些測試;

此外,排程總成會主動通知測試者何時測試;並會顯示每一機台的目前狀態及利用率,如有多個申請者申請同一時段使用同一機台,則會主動告知相關人員以進行協商,以使各種資源能達到最佳利用;

一產品驗證/監測/評估報告總成,該產品驗證/監測/評估報告總成透過該植入式可靠度分析總成及該些運





第 31 頁

余號 91120000

年月日 修正

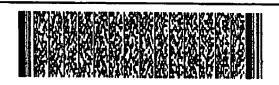
六、申請專利範圍

作相關訊息,產生與該些產品驗證/監測/評估相關之多數產品可靠度訊息;

- 一製程驗證/監測/評估報告總成,該製程驗證/監測/評估報告總成透過該植入式可靠度分析總成及該些運作相關訊息,產生與該些製程步驟相關之多數製程性能訊息;
- 一晶圓層級可靠度控制/在線製程評估/監測總成,該晶圓層級可靠度控制/在線製程評估/監測總成透過該植入式可靠度分析總成及該些運作相關訊息,直接在生產線上作監控,產生與該些產品驗證、該些機器與該些製程步驟相關之多數可靠度訊息;

一分析總成,該分析總成根據該產品報告驗證/監測/評估/總成、該製程驗證/監測/評估報告總成該晶圓層級可靠度控制/在線製程評估/監測/總成,以及失效





第 32 頁

案號 91120000 年 月 日 修正

六、申請專利範圍

分析總成產生與該些機器、該些產品與該些製程步驟相關之一綜合性資料分析。

- 19. 如申請專利範圍第18項之應用植入式可靠度分析於半導體產品生產的系統,該報告總成係根據該些產品品質訊息、該些製程性能訊息與該些可靠度訊息來產生該綜合報告。
- 20. 如申請專利範圍第18項之應用植入式可靠度分析於 半導體產品生產的系統,該分析總成係根據該些產品 品質訊息、該些製程性能訊息與該些可靠度訊息來進 行該綜合性資料分析。
- 21. 如申請專利範圍第 1 8 項之應用植入式可靠度分析於 半導體產品生產的系統,該植入式可靠度分析總成亦 會接收該綜合報告,並整合該綜合報告至該些運作相 關訊息。
- 22. 如申請專利範圍第 1 8 項之應用植入式可靠度分析於 半導體產品生產的系統,該植入式可靠度分析總成亦 會接收該綜合性資料分析,並整合該綜合性資料分析 至該些運作相關訊息。
- 23. 如申請專利範圍第18項之應用植入式可靠度分析於 半導體產品生產的系統,該植入式可靠度分析總成亦 會接收該失效報告,並整合該失效報告至該些運作相 關訊息。
- 24. 如申請專利範圍第18項之應用植入式可靠度分析於半導體產品生產的系統,該產品報告總成係透過該排



案號 91120000 年 月 日 修正

六、申請專利範圍

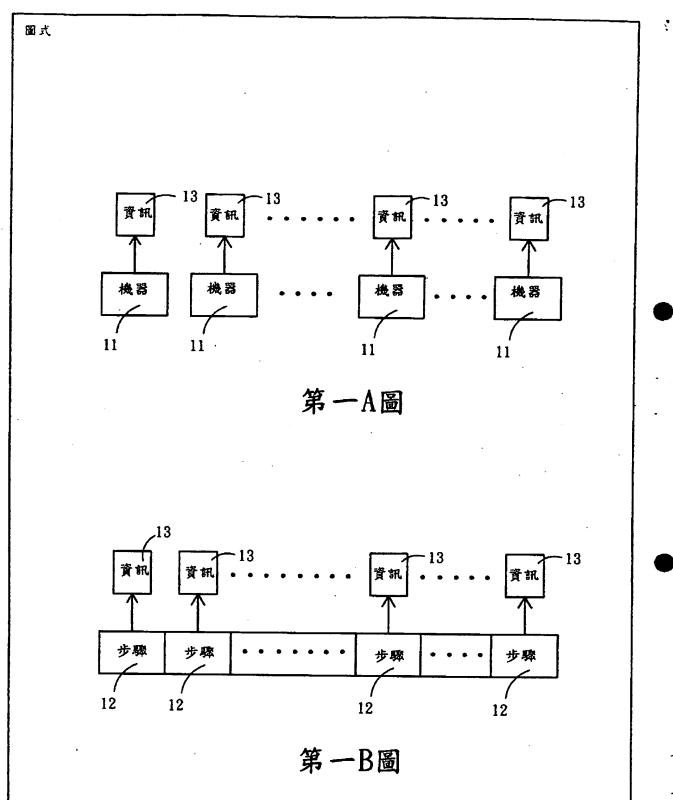
程總成與該植入式可靠度分析總成連接。

- 25. 如申請專利範圍第18項之應用植入式可靠度分析於半導體產品生產的系統,該製程報告總成係透過該排程總成與該植入式可靠度分析總成連接。
- 26. 如申請專利範圍第18項之應用植入式可靠度分析於半導體產品生產的系統,該可靠度測量總成係透過該排程總成與該植入式可靠度分析總成連接。
- 27. 如申請專利範圍第18項之應用植入式可靠度分析於 半導體產品生產的系統,該可靠度測量總成可進行一 晶圓層級可靠度分析或一封裝層級可靠度分析。
- 28. 如申請專利範圍第 1 8 項 2 應用植內 2 應用植 2 测 2 應用植 2 测 2 應用植 2 测 2 應用植 2 测 2 應用 2 完 2 完 3 完 4 等 4 等 4 的 2 年 5 的 2 年 5 的 2 年 5 的 3 是 6 的 3

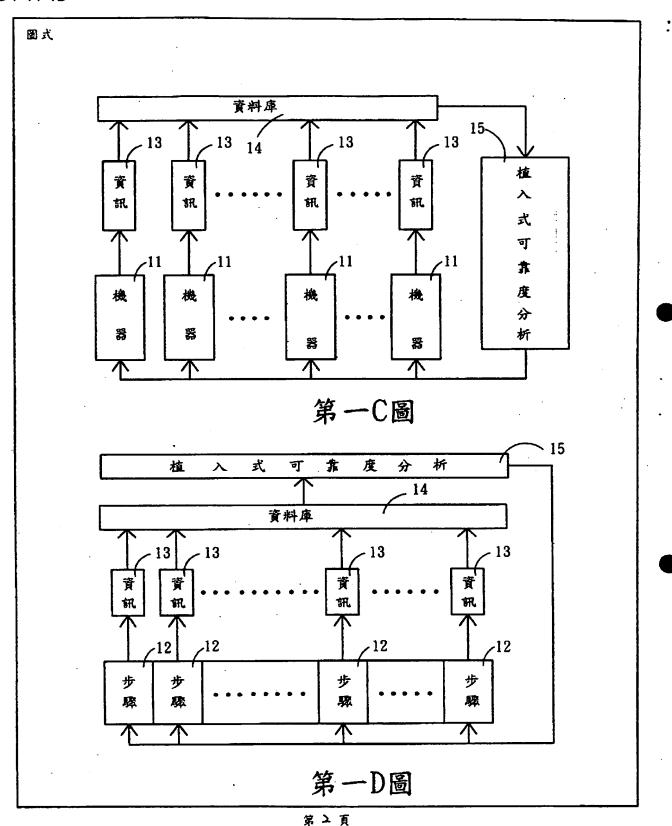




第 34 頁

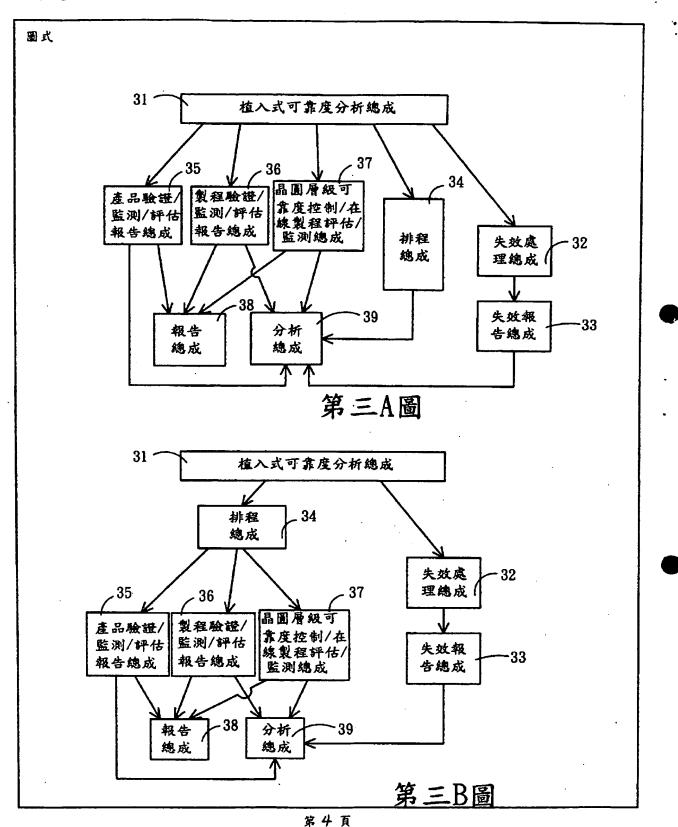


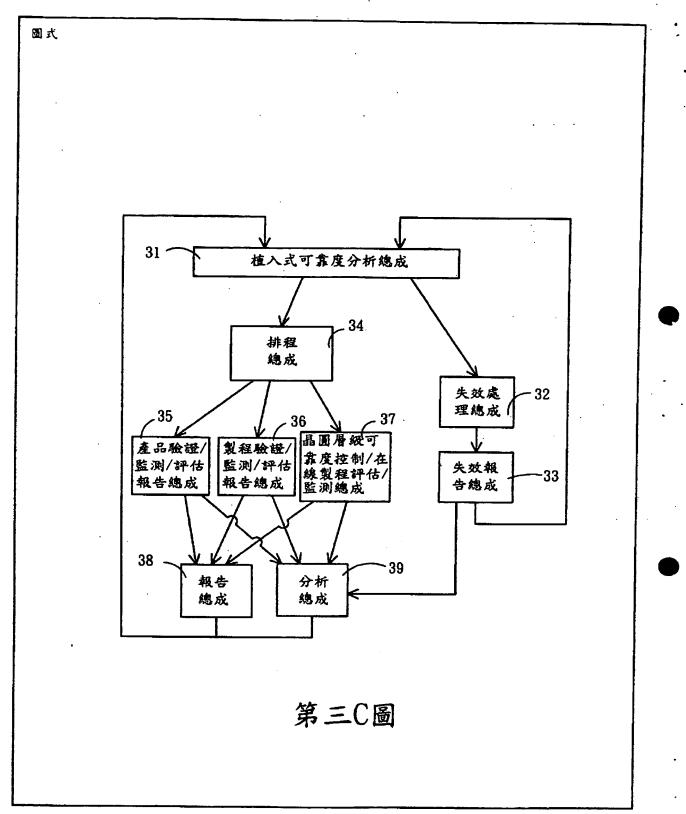
第1頁



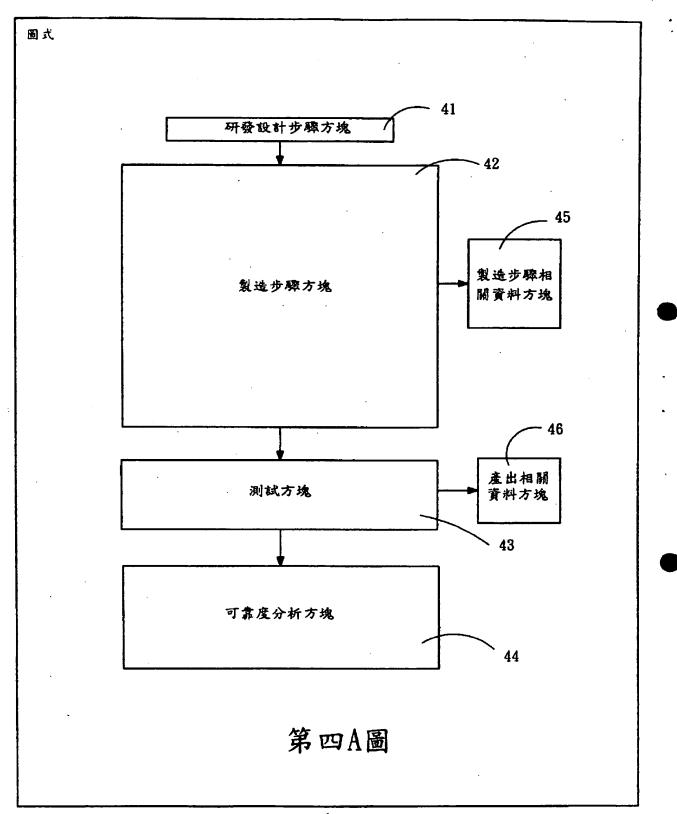
5747433%。如此日 圆式 準備多數個機器與多數個晶圓。在此任一機器是用來對至少一晶圓進行 至少一可靠度分析程序,而任一晶圓至少依序被一機器所處理。 準備一植入式可靠度分析系統。此植入式可靠度分析系統至少包 含資料庫、評估總成、基線總成、控制總成與發展總成、搜導總成 、查詢總成與分析總成。 22 参考植入式可靠度分析系統, 調整這些機器與這些可靠度分析程 序的参数。 23 使用這些機器對這些晶圓進行這些可靠度分析程序,並同時紀錄 任一可靠度分析程序、任一機器與任一晶圓之多數個資訊。 在此, 這些資訊除了至少包含任一可靠度分析程序之運作參數、 任一機器之工作參數以及任一晶圓之測量結果,更包含了可靠度 分析程序所發現或發生的問題,以及解決問題的方式。 24 分析並整合這些資訊至植入式可靠度分析系統,藉以獲得半導體 產品之產品可靠度與半導體產品製造過程之製程可靠度,並更新 植入式可靠度分析系統。 第二圖 25

第号頁





第5頁



第6頁

